

| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SIB422EDK-T1-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SIB422EDK-T1-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6 |
| | Datenblätter:  SIB422EDK-T1-GE3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 17600 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| | Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIB422EDK-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 17600 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 20V 9A (Tc) 2.5W (Ta), 13W (Tc) Surface |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SC-75-6L |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SC-75-6L Single |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 13W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 30 mOhm @ 5A, 4.5V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 8V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.5V, 4.5V |
| Vgs (Max) | ±8V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | SIB422EDK-T1-GE3TR |

SIB422EDK-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB422EDK-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB422EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB422EDK-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SIB437EDKT-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6 | SIB422EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6 | SIB437EDKT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6 | SIB433EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC-75-6 |
|  |  |  |  |
| SIB419DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6 | SIB419DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6 | SIB417EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6 | SIB441EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A PPAK SC75-6L |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| # 130MT60KB | ↔ 5SDF07F4501 | ⇒ A50QS150-4Y | D AP4578GH | ⇒ AS197-306 |
| ⊣ AT25DF161-SH-B | # BA17818FP-E2 | D C0603C0G1H070C | ⇒ C2012CH1H682K060AA | ⇒ CB047I0273JBC |
| # DG20AA60 | ⊣ DTC144TKAT146 | # FC-2012GK-S2 | ↔ GRM1885C1H4R8CZ01D | ⇒ INA163UA |
| D KDS196-RTK | # LFE9261-R | ⊣ LM74CIMX-3 | # LP3964EMPX-5.0 | ⇒ LT4320HP |
| ⇒ M5010082V | ↔ M58LT256JST | # MAL202118681E3 | ⊣ MAX3238IPWR | ⇒ MAX539ACSA+T |
| ↔ MC12017P | ⇒ MIC2211-MSBML | D PHY1078-01QT-BR | # R-781.8-0.5 | ⊣ RIAQ16EB1001FD |
| # RURD420US9A | D S-817A30APF-CUTTFG | ⇒ SESD5D5C | ↔ SIB414DK-T1-GE3 | ⇒ SIB414DK-T1-GE3 |
| ⊣ SIB422EDK-T1-GE3 | # SIB437EDKT-T1-GE3 | ↔ SIB437EDKT-T1-GE3 | ⇒ SIB900EDK-T1-GE3 | ⇒ SIB900EDK-T1-GE3 |
| # SIB911DK-T1-GE3 | ⊣ SIB911DK-T1-GE3 | # SIBA 10.NH000 | D SKIIP21NAB12T42 | ⇒ TC648BEOA |
| ↔ TCM1210G-900-2P-T000 | # TS9011PCXRF | ⊣ TXB0108YZPR | # VI-2N4-CV-01 | ⇒ ZUS254805-XSNY |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited